

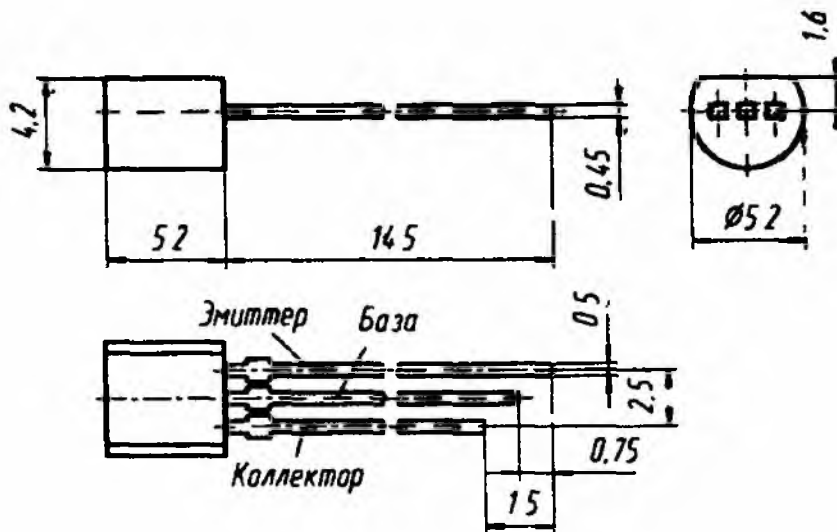
КТ350А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-n-p* универсальный. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя точками серого и розового цвета.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.

КТ350А



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 500$ мА:

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| $T = +25$ °С | 20...70*...200 |
| $T = -40$ °С | 0,5 значения при $T = +25$ °С |
| $T = +85$ °С | От 0,9 до 2 значений при $T = +25$ °С |

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА, не менее

100 МГц
280* МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_К = 500$ мА, $I_Б = 50$ мА, не более

1 В
0,19* В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_К = 500$ мА, $I_Б = 50$ мА, не более

1,25 В
0,92* В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В, не более:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $T = +25\text{ °C}$ | 1 мкА |
| $T = +85\text{ °C}$ | 15 мкА |
| Обратный ток эмиттера при $U_{зб} = 4\text{ В}$, не более | 10 мкА |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5\text{ В}$, не более | 70 пФ |
| типичное значение | 12* пФ |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{зб} = 1\text{ В}$, не более | 100 пФ |
| типичное значение | 68* пФ |

Предельные эксплуатационные данные

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Постоянное напряжение коллектор—база | 20 В |
| Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бз} \leq 10\text{ кОм}$ | 15 В |
| Постоянное напряжение эмиттер—база | 5 В |
| Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1\text{ мкс}$, $Q \geq 10$ | 600 мА |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ : | |
| при $T \leq +30\text{ °C}$ | 300 мВт |
| при $T = +85\text{ °C}$ | 162,5 мВт |
| Тепловое сопротивление переход—среда | 0,4 °C/мВт |
| Температура p-n перехода | +150 °C |
| Температура окружающей среды | -40...+85 °C |

¹ В диапазоне температур +30...+85 °C допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 5 мм при температуре не выше +250 °C и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150 °C.